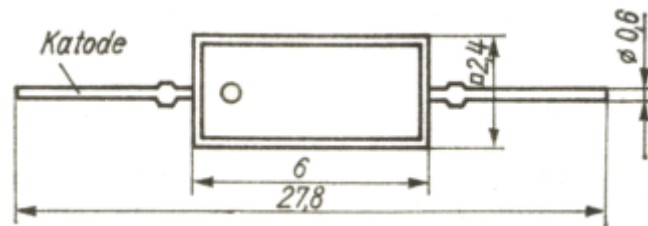


RFT SA412

Silizium- Epitaxie- Diode im Plastgehäuse zur elektronischen Bereichsumschaltung in VHF- Tunern



Grenzwerte

bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Sperrgleichspannung	U_R	=	20V
Durchlaßgleichstrom	I_F	=	80mA
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	=	100mW
Betriebstemperatur	ϑ_a	=	-25 ... +85°C
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	=	125°C

Kennwerte

bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßgleichspannung bei $I_F = 100\text{mA}$	U_F	<	1,2V
Sperrstrom bei $U_R = 20\text{V}$	I_R	<	100nA
diff. Durchlaßwiderstand bei $I_F = 10\text{mA}$, $f = 30 \dots 300\text{MHz}$	r_f	<	1 Ohm
Nullpunktkapazität bei $U_R = 0\text{V}$, $f = 0,5\text{MHz}$	C_0	<	3,1pF

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985 & 1989